

SCE 535 · SCE 537 · SCE 539

Silizium-^{npn}pp-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und
Aufsetztechnik

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand

R_{thja} auf Cevaustit 1,5 mm dick, 2,5 cm² Fläche ≤ 160 K/W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm² Fläche ≤ 125 K/W

Absolute Grenzwerte

	SCE 535	SCE 537	SCE 539
U_{CBO}	45	60	100 V
U_{CEO}	45	60	80 V
U_{EBO}		5	V
I_C		1	A
I_{CM}		1,5	A
I_B		0,1	A
P_{tot} ($\vartheta_{amb} = 25^\circ C$)			
auf Cevaustit 1,5 mm dick, 2,5 cm ² Fläche		0,8	W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm ² Fläche		1	W
ϑ_j		150	$^\circ C$
ϑ_{amb}		-65 ... +150	$^\circ C$
ϑ_{stg}		-65 ... +150	$^\circ C$

Kennwerte ($\vartheta_{amb} = 25^\circ C$)

U_{CEsat}	($I_C = 500$ mA, $I_B = 50$ mA)	$\leq 0,5$	V
U_{BE}	($U_{CE} = 2$ V, $I_C = 500$ mA)	≤ 1	V
I_{CBO}	($U_{CB} = 30$ V)	≤ 100	nA
$h_{21E}^{(1)}$	($U_{CE} = 2$ V, $I_C = 5$ mA)	> 25	
h_{21E}	($U_{CE} = 2$ V, $I_C = 150$ mA)	Gr. A 40 ... 100 Gr. B 63 ... 160 Gr. C 100 ... 250	
$h_{21E}^{(1)}$	($U_{CE} = 2$ V, $I_C = 500$ mA)	> 25	
f_T	($U_{CE} = 5$ V, $I_C = 10$ mA, $f \approx 20$ MHz)	> 50	MHz

1) Messung erfolgt impulsmäßig, $\frac{t_p}{T} = 0,01$; $t_p = 0,03$ ms